

MPS3638A

Rev.E Mar.-2016

描述 / Descriptions

TO-92 塑封封装 PNP 半导体三极管。Silicon PNP transistor in a TO-92 Plastic Package.

特征 / Features

开关晶体管。

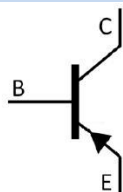
Switching Transistors.

用途 / Applications

用于普通放大。

General purpose amplifier applications.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



PIN1 : Collector PIN 2 : Base PIN 3 : Emitter

放大及印章代码 / hFE Classifications & Marking

见印章说明。See Marking Instructions.

极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	-25	V
Collector to Emitter Voltage	V_{CEO}	-25	V
Emitter to Base Voltage	V_{EBO}	-4.0	V
Collector to Emitter Voltage($V_{BE}=0$)	V_{CES}	-25	V
Collector Current - Continuous	I_C	-500	mA
Total Device Dissipation	P_D	625	mW
Junction Temperature	T_j T_{stg}	-55~150	°C

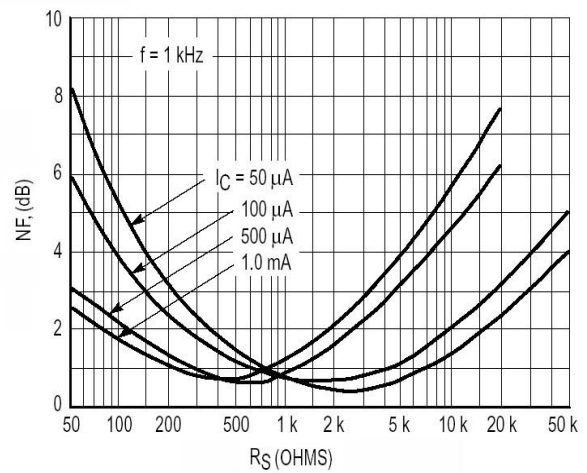
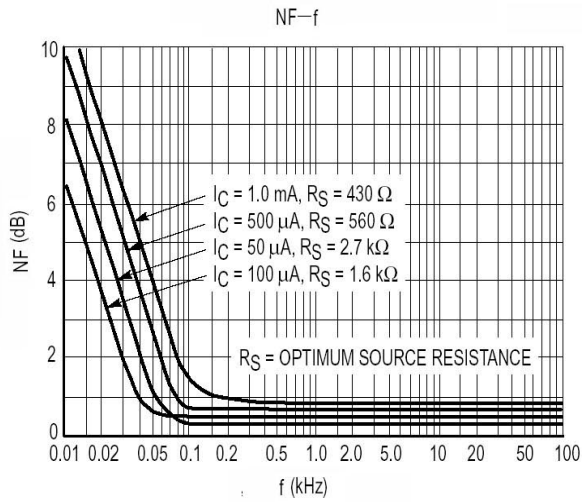
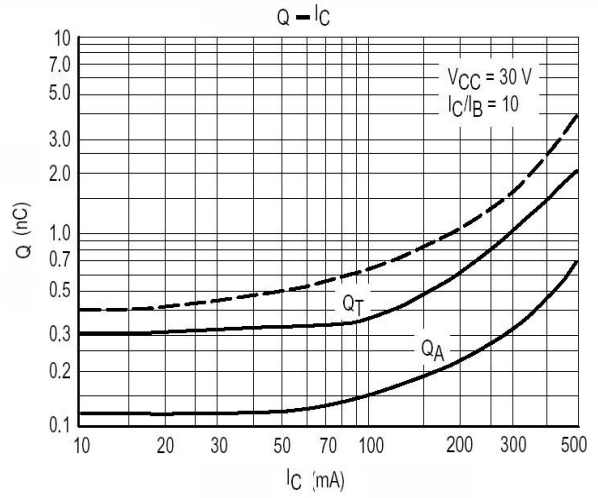
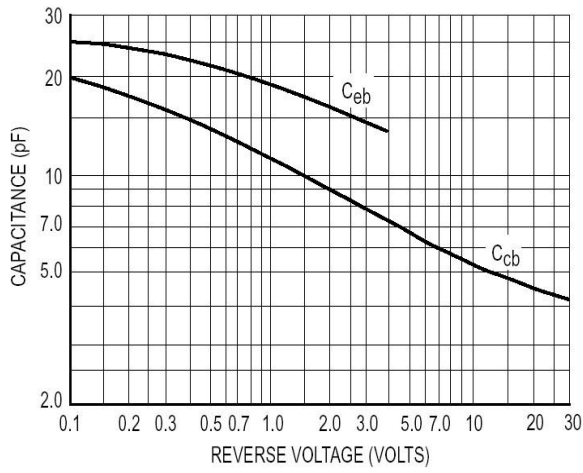
电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector-Emitter Breakdown Voltage($V_{BE}=0$)	V_{CES}	$I_C=-100\mu A$ $V_{BE}=0$	-25			V
Collector to Emitter Breakdown Voltage	V_{CEO}	$I_C=-10mA$ $I_B=0$	-25			V
Collector-Base Breakdown Voltage	V_{CBO}	$I_C=-100\mu A$ $I_E=0$	-25			V
Emitter-Base Breakdown Voltage	V_{EBO}	$I_E=-100\mu A$ $I_C=0$	-4.0			V
Collector Cutoff Current	I_{CES}	$V_{CE}=-15V$ $V_{BE}=0$	-0.035			μA
Emitter Cutoff Current	I_{EBO}	$V_{EB}=-3.0V$ $I_C=0$	-0.035			μA
Base Current	I_B	$V_{CE}=-15V$ $V_{BE}=0$	-0.035			μA
DC Current Gain	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=-1.0V$ $I_C=-50mA$	100			
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=-10V$ $I_C=-1.0mA$	80			
	$h_{FE(3)}$	$V_{CE}=-10V$ $I_C=-10mA$	100			
	$h_{FE(4)}$	$V_{CE}=-2.0V$ $I_C=-300mA$	20			
Collector to Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)(1)}$	$I_C=-50mA$ $I_B=-2.5mA$			-0.25	V
	$V_{CE(sat)(2)}$	$I_C=-300mA$ $I_B=-30mA$			-1.0	V
Base to Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)(1)}$	$I_C=-50mA$ $I_B=-2.5mA$			-1.1	V
	$V_{BE(sat)(2)}$	$I_C=-300mA$ $I_B=-30mA$	-0.8		-2.0	V

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Transition Frequency	f_T	$V_{CE}=-3V$ $I_C=-50mA$ $f=100MHz$	150			MHZ
Output Capacitance	C_{obo}	$V_{CB}=-10V$ $I_E=0$ $f=1.0MHz$			10	pF
Input Capacitance	C_{ibo}	$V_{EB}=-0.5V$ $I_C=0$ $f=1.0MHz$			25	pF
Delay Time	t_d	$V_{CC}=-10V$ $I_C=-300mA$ $I_{B1}=-30mA$			20	ns
Rise Time	t_r				70	ns
Storage Time	t_s	$V_{CC}=-10V$ $I_{B1}=-30mA$ $I_C=-300mA$ $I_{B2}=30mA$			140	ns
Fall Time	t_f				70	ns
Turn-On Time	t_{on}	$I_C=-300mA$ $I_{B1}=-30mA$			75	ns
Turn-Off Time	t_{off}	$I_C=-300mA$ $I_{B1}=-30mA$ $I_{B2}=30mA$			170	ns

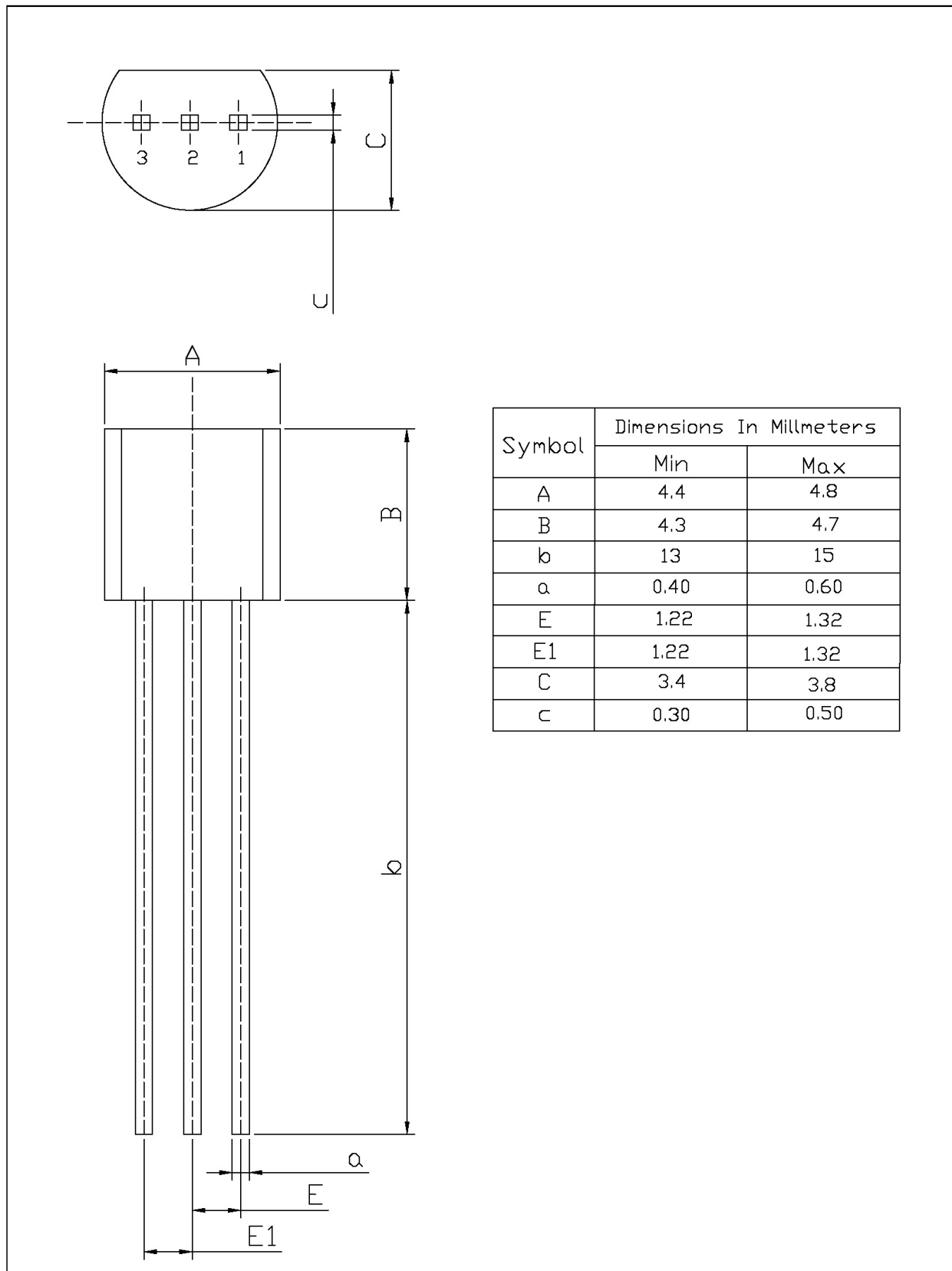
电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve



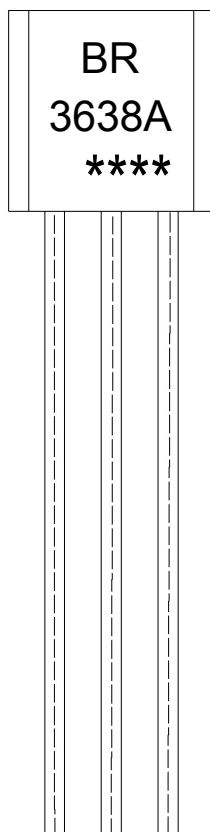
外形尺寸图 / Package Dimensions

TO-92

Unit: mm



印章说明 / Marking Instructions



说明：

BR: 为公司代码

3638A : 为型号代码

**** : 为生产批号代码，随生产批号变化。

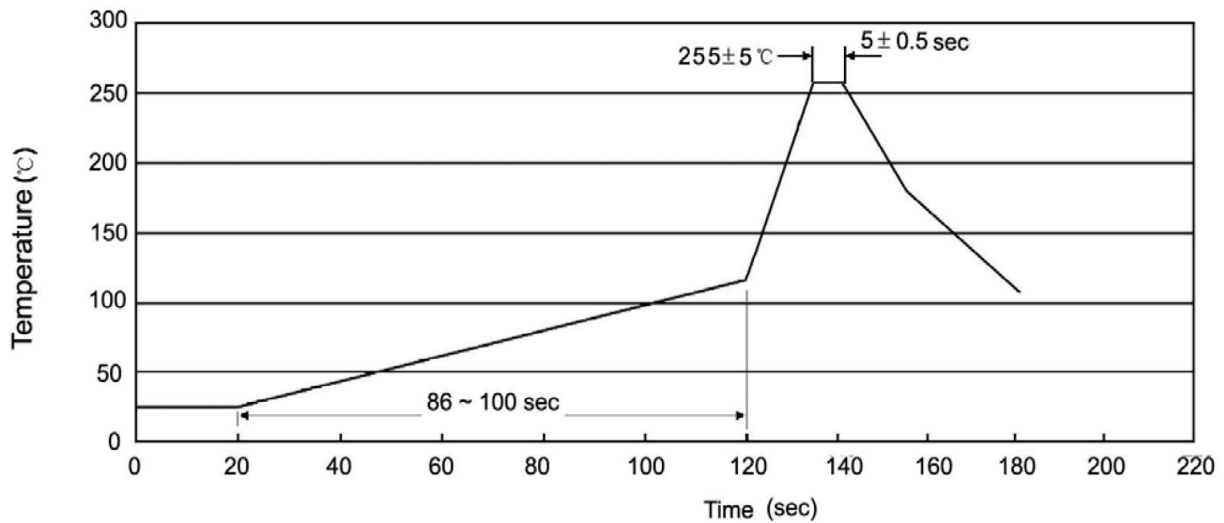
Note:

BR: Company Code.

3638A: Product Type.

****: Lot No. Code,code change with Lot No.

波峰焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)



说明：

- 1、预热温度 25 ~ 150°C，时间 60 ~ 90sec;
- 2、峰值温度 255±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2 ~ 10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:255±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：270±5°C

时间：10±1 sec.

Temp:270±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

散件包装 / BULK

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm3)		
	Units/Bag 只/袋	Bags/Inner Box 袋/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Bag 袋	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-92	1,000	10	10,000	5	50,000	135×190	237×172×102	560×245×195
	1,000	10	10,000	10	100,000	135×190	237×172×102	560×245×375

编带包装 / AMMO

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm3)	
	Units/tape 只/纸带	Tape/Inner Box 纸带/盒	Rows/Inner Box 纸带层/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-92	3,000	1	120	10	30,000	328×230×42	小箱 480×346×235, 大箱 547×407×268

使用说明 / Notices